刊行物1:

【添付書類】

刊行物1:

(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出贖公開番号

特開平7-145372

(43)公開日 平成7年(1995)6月6日

(51) Int. Cl. "

識別記号

F I

CO9K 11/06

Z 9159-4H

G03G 5/06

314

H05B 33/14

審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全13頁)

(21)出顧番号

特膜平6-209573

(22)出顧日

平成6年(1994)9月2日

(32)優先日

(31)優先權主張番号 特顧平5-246551 平5 (1993) 10月1日

(33)優先権主張国

日本(JP)

(71)出験人 000222118

東洋インキ製造株式会社

東京都中央区京橋2丁目3番13号

(72) 発明者 榎田 年男

東京都中央区京橋二丁目3番13号 東洋イ

ンキ製造株式会社内

(72) 発明者 小川 但

東京都中央区京橋二丁目3番13号 東洋イ

ンキ製造株式会社内

(72)発明者 須田 康政

東京都中央区京橋二丁目3番13号 東洋イ

ンキ製造株式会社内

(54) 【発明の名称】正孔輪送材料およびその用途

(57)【要約】

【目的】 正孔輸送性の優れた正孔輸送材料を提供する ことにあり、正孔輸送材料を使用する案子、高輝度・高 発光効率、発光劣化が少なく信頼性の高いエレクトロル ミネッセンス素子、感度、正孔輸送特性、初期表面電 位、暗蔵衰率等の電子写真特性の良好な電子写真感光体 を提供することを目的とする。

【構成】 一般式[1]からなる正孔輸送材料

【化1】

[式中、R'ないしR'*は、それぞれ独立に、水素原 子、ハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、チオア ルコキシ基、シアノ基、アミノ基、モノまたはジ置換ア ミノ基、水酸基、メルカプト基、アリールオキシ基、ア リールチオ基、炭素環式芳香族環基、複素環式芳香族環 基、複素環基を表し、R'ないしR''のうち少なくとも 一つ、および、R'*ないしR'*のうち少なくとも一つ。 が、アミノ基、モノ置換アミノ基もしくはジ置換アミノ 基である。〕

(2)

特開平7 145372

【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記一般式 [1] で示される正孔輸送材 料一般式[1]

【化1】

[式中、R'ないしR''は、それぞれ独立に、水業原 子、ハロゲン原子、置換もしくは未置換のアルキル基、 置換もしくは未置換のアルコキシ基、置換もしくは未置 榛のチオアルコキシ基、シアノ基、アミノ基、モノまた はジ置換アミノ基、水酸基、メルカプト基、置換もしく は未置換のアリールオキシ基、置換もしくは未置換のア リールチオ基、置換もしくは未置換の炭素環式芳香族環 基、置換もしくは未置換の複素環式芳香族環基、置換も しくは未置機の複素環基を表す。また、隣接した置換基 同上で鬱逸もしくは未鬱趣の脂肪族式環、鬱梅もしくは 未覺棒の炭素環式芳香族環、置換もしくは未置機の複素 環式芳香族環基、置換もしくは未覆換の複素環を形成し ても良い。ここで、R*ないしR**のうち少なくとも一 つ、および、R¹⁴ないしR¹⁸のうち少なくとも一つが、

【請求項2】 一対の電極間に、一層または複数層の有 機化合物薄膜よりなる発光層を備えた有機エレクトロル ミネッセンス素子において、少なくとも一層が請求項1 記載の有機エレクトロルミネッセンス素子材料を含有す る層であることを特徴とする有機エレクトロルミネッセ ンス素子。

【請求項3】 少なくとも一層が発光層である請求項2 記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項4】 少なくとも一層が正孔注入層である請求 40 項2記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項5】 導電性支持体上に、電荷発生材料および 正孔輸送材料を使用してなる電子写真感光体において、 正孔輸送材料が、請求項1記載の正孔輸送材料であるこ とを特徴とする電子写真感光体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明はフルオレン構造を有する 正孔輸送材料に関し、核フルオレン化合物は、感光材 料、有機光導電材料として使用でき、さらに具体的に

は、平面光源や表示に使用される有機エレクトロルミネ ッセンス(EL)妻子もしくは電子写真戚光体等の正孔 輸送材料として利用できる。

2

[0002]

【従来の技術】感光材料や正孔輸送材料として開発され てい<mark>る有機光導電材料は、</mark>低コスト、加工性<mark>が多様で</mark>あ り、無公害性などの多くの利点があり、多くの化合物が 提案されている。例えば、オキサジアゾール誘導体(米 国特許第3、189、447号)、オキサゾール誘導体 10 (米国特許第3、257、203号)、ヒドラゾン誘導 体 (米国特許第3, 717, 462号、特開昭54-5 9, 143号、米国特許第4, 150, 978号)、ト リアリールピラゾリン誘導体(米国特許第3、820, 989号、特開昭51-93, 224号、特開昭55-108, 667号)、アリールアミン誘導体(米国特許 第3, 180, 730号、米国特許第4, 232, 10 3号、特開昭55-144, 250号、特開昭56-1 19, 132号)、スチルベン誘導体(特開昭58-1 90, 953号、特開昭59-195, 658号) など の有機光導電性材料が開示されている。

【0003】正孔輸送材料を利用した技術の一つとして は、有機EL素子が挙げられる。有機物質を使用したE L素子は、固体発光型の安価な大面積フルカラー表示素 モとしての用途が有望視され、多くの開発が行われてい
 る。一般にELは発光層および該層をはさんだ一対の対 向電極から構成されている。発光は、両電極間に電界が 印加されると、陰極側から電子が注入され、陽極側から 正孔が注入される。さらに、この電子が発光層において 正孔と再結合し、エネルギー準位が伝導帯から価電子帯 アミノ基、モノ置換アミノ基もしくはジ置換アミノ基で 30 に戻る際にエネルギーを光として放出する現象である。 【0004】従来の有機EL素子は、無機EL素子に比 べて駆動電圧が高く、発光輝度や発光効率も低かった。 また、特性劣化も著しく実用化には至っていなかった。 近年、10 V以下の低電圧で発光する高い蛍光量子効率 を持った有機化合物を含有した薄膜を積層した有機EL 素子が報告され、関心を集めている(アプライド・フィ ジクス・レターズ、51巻、913ページ、1987年 参照)。この方法は、金属キレート錯体を蛍光体層、ア ミン系化合物を正孔注入層に使用して、高輝度の緑色発 光を得ており、6~7Vの直流電圧で輝度は100cd /m²、最大発光効率は1.51m/Wを達成して、実 用領域に近い性能を持っている。

> 【0005】しかしながら、現在までの有機EL素子 は、構成の改善により発光強度は改良されているが、未 だ充分な発光輝度は有していない。また、繰り返し使用 時の安定性に劣るという大きな問題を持っている。従っ て、より大きな発光輝度を持ち、繰り返し使用時での安 定性の優れた有機EL素子の開発のために、優れた正孔 輸送能力を有し、耐久性のある正孔輸送材料の開発が望 50 まれている。

(3)

特勝平7-145372

【0006】さらに、正孔輸送材料を利用した技術とし ては、電子写真感光体が挙げられる。電子写真方式は、 カールソンにより発明された画像形成法の一つである。 この方式は、コロナ放電により感光体を帯電した後、光 像鷗光して感光体に舒電潜像を得、該静電潜像にトナー を付着させて現像し、得られたトナー像を紙へ転写する ことからなる。このような電子写真方式における感光体 に要求される基本的な特性としては、暗所において適当 な電位が保持されること、暗所における電荷の放電が少 ないこと、光照射により速やかに電荷を放電することな 10 どが挙げられる。従来までの電子写真感光体は、セレ ン、セレン合金、酸化亜鉛、硫化カドミウムおよびテル ルなどの無機光導電体が使用されてきた。これらの無機 光導電体は、耐久性が高く、耐刷枚数が多いなどの利点 を有しているが、製造コストが高く、加工性が劣り、毒 性を有するなどの問題点が指摘されている。これらの欠 点を克服するために有機感光体の開発が行われている が、従来までの有機光導電材料を正孔輸送材料として用 いた電子写真感光体は、帯電性、感度および残留電位な どの電子写真特性が、必ずしも満足されているものとは 20 言えないのが現状であり、優れた電荷輸送能力を有し、 耐久性のある正孔輸送材料の開発が望まれていた。 [0007]

3

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、優れた正孔輸送能力を有し、耐久性のある正孔輸送材料を提供することにあり、さらにこの正孔輸送材料を繰り返し使用時での安定性の優れた有機EL素子、電子写真感光体を提供することを目的とする。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明者らは鋭意検討した結果、一般式 [1] で示される少なくとも一種の正孔輸送材料は、正孔輸送能力が大きく、これを用いて作製した有機EL素子もしくは電子写真感光体等の素子の感度もしくは繰り返し使用時での安定性が優れていることを見いだし本発明に至った。一般式 [1] 【化2】

【式中、R¹ないしR^{1*}は、それぞれ独立に、水素原 ブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基、ヘ イ、ハロゲン原子、置換もしくは未置換のアルキル基、 ンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ステ 置換もしくは未置換のアルコキシ基、置換もしくは未置 50 アリル基、トリクロロメチル基、シクロプロビル基、シ

換のチオアルコキシ基、シアノ基、アミノ基、モノまたはジ置換アミノ基、水酸基、メルカプト基、酸換もしくは未置換のアリールオキシ基、置換もしくは未置換の炭素環式芳香族環基、置換もしくは未置換の複素環式芳香族環基、置換もしくは未置換の複素環式芳香族環基、置換もしくは未置換の複素環式芳香族環基、置換もしくは未置換の複素環式芳香族環基、置換もしくは未置換の複素環である。ここで、R*ないしR**のうち少なくとも一つ、および、R**ないしR**のうち少なくとも一つ、および、R**ないしR**のうち少なくとも一つ、および、R**ないしR**のうち少なくとも一つ、および、R**ないしR**のうち少なくとも一つ、および、R**ないしR**のうち少なくとも一つが、アミノ基、モノ置換アミノ基もしくはジ置換アミノ基である。]

【0009】第二の発明は、一対の電極間に、一層または複数層の有機化合物薄膜よりなる発光層を備えた有機 エレクトロルミネッセンス案子において、少なくとも一 層が一般式 [1] で示される化合物を含有する層である 有機エレクトロルミネッセンス素子である。

【0010】第三の発明は、少なくとも一層が発光層である上記有機エレクトロルミネッセンス素子である。 【0011】第四の発明は、少なくとも一層が正礼注入層である上記有機エレクトロルミネッセンス素子であま

【0012】第五の発明は、導電性支持体上に、電荷発生材料および正孔輸送材料を使用してなる電子写真感光体において、上記正孔輸送材料が、上記式[1]で示される化合物であることを特徴とする電子写真感光体である。

【0013】本発明における一般式[1]で示される化 合物の、R¹ないしR¹⁸は、それぞれ独立に、水素原 子、ハロゲン原子、置換もしくは未置換のアルキル基、 置換もしくは未置換のアルコキシ基、置換もしくは未置 **換のチオアルコキシ基、シアノ基、アミノ基、モノまた** はジ置換アミノ基、水酸基、メルカプト基、置換もしく は未開機のアリールオキシ基、耐複もしくは未開機のア リールチオ基、置換もしくは未置換の炭素環式芳香族環 基、置換もしくは未置換の複素環式芳香族環基、置換も しくは未置換の複素環基を表す。また、隣接した置換基 同士で置換もしくは未置換の脂肪族式源、置換もしくは 未置換の炭素環式芳香炭環、置拠もしくは未置換の莨素 環式芳香族環基、置換もしくは未置換の複素環を形成し ても良い。ここで、R*ないしR14のうち少なくとも一 つ、および、R^{LL}ないしR^{LL}のうち少なくとも一つが、 アミノ基、モノ置換アミノ基もしくはジ置換アミノ基で ある。R¹ないしR¹゚の具体例は、ハロゲン原子として は弗素、塩素、臭素、ヨウ素、置換もしくは未置換のア ルキル基としては、メチル基、エチル基、プロビル基、 ブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基、ヘ ンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ステ

(4)

特燉平7-145372

ある。

クロヘキシル基、1,3-シクロヘキサジエニル基、2 ーシクロペンテン-1-イル基、2, 4ーシクロペンタ ジエンー1-イリデニル基等がある。置換もしくは未置 換のアルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、 プロポキシ基、n‐プトキシ基、sec‐プトキシ基、 tert-ブトキシ基、ペンチルオキシ基、ヘキシルオ キシ基、ステアリルオキシ基等がある。置換もしくは未 置機のチオアルコキシ墓としては、メチルチオ墓、エチ ルチオ基、プロビルチオ基、プチルチオ基、sec-フ チルチオ基、tert-ブチルチオ基、ペンチルチオ **基、ヘキシルチオ基、ヘプチルチオ基、オクチルチオ基** 等がある。モノまたはジ置換アミノ基としては、メチル アミノ基、ジメチルアミノ基、エチルアミノ基、ジエチ ルアミノ基、ジブロビルアミノ基、ジプチルアミノ基、 ジフェニルアミノ基、ビス (アセトオキシメチル) アミ ノ基、ビス (アセトオキシエチル) アミノ基、ビス (ア セトオキシブロピル) アミノ基、ビス (アセトオキシブ チル) アミノ基、ジベンジルアミノ基等がある。 置換も しくは未置換のアリールオキシ基としては、フェノキシ 基、p-tert-ブチルフェニキシ基、3-フルオロ 20 フェニキシ基等がある。置換もしくは未置換のアリール チオ基としては、フェニルチオ基、3-フルオロフェニ ルチオ基等がある。置換もしくは未置換の炭素環式芳香 族環基としては、フェニル基、ビフェニレニル基、トリ フェニレニル基、テトラフェニレニル基、3-ニトロフ ェニル基、4 - メチルチオフェニル基、3, 5 - ジシア ノフェニル基、o-,m-およびp-トリル基、キシリ ル基、o-,m-およびp-クメニル基、メシチル基、 ペンタレニル基、インデニル基、ナフチル基、アズレニ ル基、ヘプタレニル基、アセナフチレニル基、フェナレ 30 ムのような無機塩基、ピリジン、ビコリン、トリエチル ニル基、フルオレニル基、アントリル基、アントラキノ ニル基、3-メチルアントリル基、フェナントリル基、 トリフェニレニル基、ピレニル基、クリセニル基、2-エチルー1-クリセニル基、ピセニル基、ベリレニル 基、6-クロロペリレニル基、ペンタフェニル基、ペン タセニル基、テトラフェニレニル基、ヘキサフェニル 基、ヘキサセニル基、ルビセニル基、コロネニル基、ト リナフチレニル基、ヘプタフェニル基、ヘプタセニル 基、ピラントレニル基、オバレニル基等等がある。置換 もしくは未置機の複素環式芳香族環基としては、チオニ 40 ル基、フリル基、ピロリル基、イミダブリル基、ピラブ リル基、ピリジル基、ピラジニル基、ピリミジニル基、 ピリダジニル基、インドリル基、キノリル基、イソキノ リル基、フタラジニル基、キノキサリニル基、キナソリ ニル茎、カルバソリル茎、アクリジニル基、フェナジニ ル基、フルフリル基、イソチアソリル基、イソキサソリ ル基、フラザニル基、フェノキサジニル基、ベンソチア ソリル基、ベンソオキサソリル基、ベンズイミダゾリル

墓、2-メチルピリジル墓、3-シアノビリジル墓等が

【0014】ここで、R'ないしR''のうち少なくとも ーつ、および、R¹¹ないしR¹¹のうち少なくとも一つ が、アミノ基、モノ電換アミノ基もしくはジ置換アミノ 基であり、アミノ基に置換される置換基としては、R1 ~ R''を構成する置換基として具体例で示したものであ っても良いが、好ましくは以下のものが挙げられる。置 換もしくは未置換のアルキル基としては、メチル基、エ チル基、プロビル基、tert-プチル基等があり、置 10 換もしくは未置機の炭素環式芳香族基としては、フェニ ル基、oートリル基、mートリル基、pートリル基、p - クロロフェニル基、p – メトキシフェニル基、p – (N, N-ジフェニル) アミノフェニル基等がある。置 換もしくは未置換の複素漿基としては、ビリジン基、ビ ラジン基、ピリミジン基、トリアジン基、キノキサリン 基等があるが、上記置換基に具体的に限定されるもので

【0015】本発明において、一般式[1]で示される 化合物は、例えば以下の方法により製造することができ ర్.

【0016】一般式 [1] の本発明の化合物は、一般式 [1] の基本骨格のアミノ基に、ハロゲン等を置換基と して持つ誘導体化合物を、窒素雰囲気下、有機溶媒中ま たは無溶媒で、塩基および触媒の存在下で、所定の温 度、所定の時間反応させて得ることが出来る。

【0017】本発明の化合物の合成で用いられるハロゲ ン置換基は、塩素、臭素、沃素等が挙げられ、特にアミ ノ基に対する電換が容易である。本発明で使用される塩 基は、炭酸カリウム、水酸化リチウム、水酸化ナトリウ アミン、N-メチルピロリジン、1,5-ジアザビシク ロ [5, 4, 0] ウンデセン (DBU) のような有機塩 基が挙げられる。本発明で使用される触媒は、銅粉、酸 化銅、ハロゲン化銅、硫酸銅等か挙げられる。本発明で 使用される溶媒は、原料を溶解して、反応を行なわせる ことが出来るものであればいずれのものでも良い。例え ば、トルエン、キシレン、ニトロベンゼン、ジメチルス ルホキシド、N、N-ジメチルホルムアミド等の溶媒が 挙げられる。酸触媒は、濃硫酸、pートルエンスルホン 酸、ポリリン酸、TIC1,、AIC1,、ポリエチレン スルホン酸等が挙げられる。還元剤としては、Zn、S n、H₂/Pt、H₂/Pd、H₂/Ni等が挙げられ

【0018】以下に、本発明の化合物の代表例を表1に 具体的に例示するが、本発明は以下の代表例に限定され るものではない。

[0019]

【表1】

特開平7-145372 (5)

化合物	化学排造			
(1)	, o o o o o o			
(2)				
(3)	6 6 			
(4)				

[0020]

(6) 化合物 (5) (6) (7) (8)

[0021]

特開平7-145372

10

(7) 特開平7-145372 11 12 化合物 化学模造 (9) (10)(11)(12)

[0022]

化合物	化学 的 选
(13)	
(14)	0,000
(15)	30.00.00

【0023】本発明の正孔輸送材料は、他の正孔もしく は電子輸送材料と混合して使用してもさしつかえない。 本発明の化合物は正孔輸送性に優れているので、正孔輸 送性材料として極めて有効に使用することができる。

機EL素子の正孔輸送材料として用いる場合について説 明する。図1~3に、本発明で使用される有機EL素子 の模式図の一例を示した。図中、一般的に電極Aである 2は陽極であり、電極Bである6は陰極である。また、 【0024】まず、一般式[1]で示される化合物を有 50 (電極A/発光層/電子注入層/電極B)の層構成で積 囲がさらに好ましい。

(8)

特開平7-145372

13

層した有機EL案子もあり、一般式[1]の化合物は、 どの妻子構成においても好適に使用することが出来る。 一般式[1]の化合物は、大きな正孔輸送能力をもって いるので、正孔注入層3もしくは発光層4のいずれの層 においても、正孔輸送材料として使用できる。

【0025】図1の発光層4には、必要があれば、本発明の一般式[1]の化合物に加えて、発光物質、発光補助材料、キャリア輸送を行う正孔輸送材料や電子輸送材料を使用することもできる。図2の構造は、発光層4と正孔注入層3を分離している。この構造により、正孔注 10入層3から発光層4への正孔注入効率が向上して、発光輝度や発光効率を増加させることができる。この場合、発光効率のためには、発光層に使用される発光物質自身が電子輸送性であること、または発光層中に電子輸送輸送材料を添加して発光層を電子輸送性にすることが望ましい。

【0026】図3の構造は、正孔注入層3に加えて電子 注入層5を有し、発光層4での正孔と電子の再結合の効 率を向上させている。このように、有機EL素子を多層 構造にすることにより、クエンチングによる輝度や寿命 20 の低下を防ぐことができる。図2および図3の素子においても、必要があれば、発光物質、発光補助材料、キャ リア輸送を行う正孔輸送材料や電子輸送材料を組み合わ せて使用することが出来る。また、正孔注入層、発光 層、電子注入層は、それぞれ二層以上の層構成により形 成されても良い。

【0027】有機EL素子の陽極に使用される導電性物質としては、4eVより大きな仕事関数を持つものが好適であり、炭素、アルミニウム、パナジウム、鉄、コパルト、ニッケル、タングステン、銀、金、白金、パラジ 30 ウム等およびそれらの合金、1TO基板、NESA基板と称される酸化スズ、酸化インジウム等の酸化金属、さらにはポリチオフェンやポリビロール等の有機導電性樹脂が用いられる。陰極に使用される導電性物質としては、4eVより小さな仕事関数を持つものが好適であり、マグネシウム、カルシウム、錫、鉛、チタニウム、イットリウム、リチウム、ルテニウム、マンガン等およびそれらの合金が用いられるが、これらに限定されるものではない。陽極および陰極は、必要があれば二層以上の層標成により形成されていても良い。 40

【0028】有機EL素子では、効率良く発光させるために、2で示される電極Aまたは6で示される電極Bのうち、少なくとも一方は素子の発光液長價域において充分透明にすることが望ましい。また、基板1も透明であることが望ましい。透明電極は、上記した専電性物質を使用して、蒸着やスパッタリング等の方法で所定の透光性が確保するように設定する。発光面の電極は、光透過率を10%以上にすることが望ましい。

【0029】墓板1は、機械的、熱的強度を有し、適明なものであれば限定されるものではないが、例示する

と、ガラス基板、ポリエチレン板、ポリエーテルサルフォン板、ポリプロピレン板等の透明樹脂があげられる。 【0030】本発明に保わる有機EL素子の各層の形成は、真空無着、スパッタリング等の範式成膜法のいずれの方法を適用することができる。膜厚は特に限定されるものではないが、各層は適切な膜厚に設定する必要がある。膜厚が厚すぎると、一定の光出力を得るために大きな印加電圧が必要になり効率が悪くなる。膜厚が薄すぎるとピンホール等が発生して、電界を印加しても充分な発光輝度が得られない。通常の膜厚は5 n mから10 μ mの範囲が好適であるが、10 n mから0.2 μ mの範

14

【0031】湿式成膜法の場合、各層を形成する材料を、クロロフォルム、テトラヒドロフラン、ジオキサン等の適切な溶媒に溶解または分散して薄膜を形成するが、その溶媒はいずれであっても良い。また、いずれの薄膜においても、成膜性向上、膜のピンホール防止等のため適切な樹脂や添加剤を使用しても良い。このような樹脂としては、ポリスチレン、ポリカーボネート、ポリアリレート、ポリエステル、ポリアミド、ポリウレタン、ポリスルフォン、ポリメチルメタクリレート、ポリメチルアクリレート、セルロース等の絶縁性樹脂、ポリートービニルカルバゾール、ポリシラン等の光導電性樹脂を挙げることができる。

【0032】本有機EL素子は、発光層、正孔注入層、電子注入層において、必要があれば、一般式 [1] の化合物に加えて、公知の発光物質、発光補助材料、正孔輸送材料、電子輸送材料を使用することもできる。

【0033】公知の発光物質または発光物質の補助材料としては、アントラセン、ナフタレン、フェナントレン、ピレン、テトラセン、コロネン、クリセン、フルオレセイン、ペリレン、フタロペリレン、ナフタロペリノン、プラロペリノン、プラロペリノン、プラロペリノン、プラロペリノン、プラロペリノン、プラロペリノン、グマリン、オキサジアゾール、アルダジン、ビスペンゾキナン、オキシン、アミノキノリン、イミン、ジフェニルエチレン、ビニルアントラセン、ジアミノカルバゾール、ビラン、チオピラン、ポリメチン、メロシアニン、イミグゾールキレート化オキシノイド化合物、キナクリドン、ルブレン等およびそれらの誘導体があるが、これらに限定されるものではない。

【0034】一般式[1]の正孔輸送材料と併せて使用できる正孔輸送材料としては、正孔を輸送する能力を持ち、発光層または発光物質に対して優れた正孔注入効果を有し、発光層で生成した励起子の電子注入層または電子輸送材料への移動を防止し、かつ薄膜形成能の優れた50 化合物が挙げられる。具体的には、フタロシアニン系化

(9)

特開平7-145372

16

合物、ナフタロシアニン系化合物、ポルフィリン系化合 物、オキサジアゾール、トリアゾール、イミダゾール、 イミダゾロン、イミダゾールチオン、ピラブリン、ピラ ゾロン、テトラヒドロイミダソール、オキサソール、オ キサジアゾール、ヒドラゾン、アシルヒドラゾン、ポリ アリールアルカン、スチルベン、ブタジエン、ベンジジ ン型トリフェニルアミン、スチリルアミン型トリフェニ ルアミン、ジアミン型トリフェニルアミン等と、それら の誘導体、およびポリビニルカルバゾール、ポリシラ ン、導電性高分子等の高分子材料等があるが、これらに 10 限定されるものではない。

15

【0035】電子輸送材料としては、電子を輸送する能 力を持ち、発光層または発光物質に対して優れた電子注 入効果を有し、発光層で生成した励起子の正孔注入層ま たは正孔輸送材料への移動を防止し、かつ薄膜形成能の 優れた化合物が挙げられる。例えば、フルオレノン、ア ントラキノジメタン、ジフェノキノン、チオピランジオ キシド、オキサジアゾール、ベリレンテトラカルボン 酸、フレオレニリデンメタン、アントラキノジメタン、 アントロン等とそれらの誘導体があるが、これらに限定 20 が挙げられる。 されるものではない。また、正孔輪送材料に電子受容物 質を、電子輸送材料に電子供与性物質を添加することに より増感させることもできる。

【0038】図1, 2および3に示される有機EL素子 において、本発明の一般式[1]の化合物は、いずれの 層に使用することができ、一般式 [1] の化合物の他 に、発光物質、発光補助材料、正孔輸送材料および電子 輸送材料の少なくとも1種が同一層に含有されてもよ い。また、本発明により得られた有機EL寮子の、温 度、湿度、雰囲気等に対する安定性の向上のために、薬 30 クロンであり、正孔輸送層は5から50ミクロン、好ま 子の表面に保護層を設けたり、シリコンオイル等を封入 して素子全体を保護することも可能である。以上のよう に、本発明では有機EL素子に一般式「1]の化合物を 用いたため、発光効率と発光輝度を高くできた。また、 この素子は熱や電流に対して非常に安定であり、さらに は低い駆動電圧で実用的に使用可能の発光輝度が得られ るため、従来まで大きな問題であった劣化も大幅に低下 させることができた。

【0037】本発明の有機EL素子は、整掛けテレビ等 のフラットパネルディスプレイや、平面発光体として、 複写機やブリンター等の光源、液晶ディスプレイや計器 類等の光源、表示板、標識灯等へ応用が考えられ、その 工業的価値は非常に大きい。

【0038】次に、本発明の一般式[1]で示される化 合物を電子写真感光体として用いる場合について説明す る。本発明の一般式[1]で示される化合物は、電子写 真感光体の何れの層においても使用できるが、高い正孔 輸送特性を有することから正孔輸送材料として使用する ことが望ましい。該化合物は正孔輸送材料として作用

よく輸送でき、高速応答性の感光体を得ることができ る。また、該化合物は、耐オゾン性、光安定性に優れて いるので、耐久性に優れた感光体を得ることができる。 【0039】電子写真感光体は、導電性基板上に電荷発 生材料と、必要があれば電荷輸送材料を結着樹脂に分散 させてなる感光層を設けた単層型感光体、導電性基板上 に下引き層、電荷発生層、正孔輸送層の順に積層した、 もしくは導電性基板または下引き層上に正孔輸送層、電 荷発生層の順に積層した積層型感光体等がある。ここ で、下引き層は必要がなければ使用しなくても良い。上 記感光体は、必要があれば活性ガスからの表面保護およ びトナーによるフィルミング防止等の意味でオーバーコ 一ト層を設けることも出来る。

【0040】電荷発生材料としては、ビスアゾ、キナク リドン、ジケトピロロピロール、インジゴ、ペリレン、 ペリノン、多環キノン、スクアリリウム塩、アズレニウ ム塩、フタロシアニン、ナフタロシアニン等の有機化合 物、もしくは、セレン、セレンーテルル合金、硫化カド ミウム、酸化亜鉛、アモルファスシリコン等の無機物質

【0041】感光体の各層は蒸着もしくは分散塗工方式 により成膜することが出来る。分散塗工は、スピンコー ター、アプリケーター、スプレーコーター、浸漬コータ ー、ローラーコーター、カーテンコーターおよびピード コーター等を用いて行い、乾燥は室温から200℃、1 0分から6時間の範囲で静止または送胤条件下で行う。 乾燥後の感光層の膜厚は単層型感光体の場合、5ミクロ ンから50ミクロン、積層型感光体の場合、電荷発生層 は0.01から5ミクロン、好ましくは0.1から1ミ しくは10から20ミクロンが好適である。

【0042】単層型感光体の感光層、積層型感光体の電 荷発生層もしくは正孔輸送層を形成する際に使用する樹 脂は広範な絶縁性樹脂から選択出来る。また、ポリ N ーピニルカルパゾール、ポリビニルアントラセンやポリ シラン類などの有機光導電性ポリマーから選択出来る。 好ましくは、ポリビニルブチラール、ポリアリレート、 ポリカーボネート、ポリエステル、フェノキシ、アクリ ル、ポリアミド、ウレタン、エポキシ、シリコン、ポリ スチレン、ポリ塩化ビニル、塩酢ビ共重合体、フェノー ルおよびメラミン樹脂等の絶縁性樹脂を挙げることが出 来る。電荷発生層もしくは正孔輸送層を形成するために 使用される樹脂は、電荷発生材料もしくは正孔輸送材料 に対して、100重量%以下が好ましいがこの限りでは ない。樹脂は2種類以上組み合わせて使用しても良い。 また、必要があれば樹脂を使用しなくてもよい。また、 電荷発生層を蒸着、スパッタリング等の物理的成膜法に より形成させることも出来る。蒸着、スパッタリング法 では、好ましくは10⁻³Toor以下の真空雰囲気下で し、光を吸収することにより発生した電荷を極めて効率 50 成膜することが望ましい。また、窒素、アルゴン、ヘリ

(10)

10

特開平7-145372

18

ウム等の不活性ガス中で成膜することも可能である。 【0043】電子写真感光体の各層を形成する際に使用する溶剤は、下引き層や他の感光層に影響を与えないものから選択することが好ましい。具体的には、ベンゼン、キシレン等の芳香族炭化水素、アセトン、メチルエチルケトン、シクロヘキサノン等のケトン類、メタノール、エタノール等のアルコール類、酢酸エチル、メチルセロソルブ等のエステル類、四塩化炭素、クロロホル

17

ル、エタノール等のアルコール類、酢酸エチル、メチル セロソルブ等のエステル類、四塩化炭素、クロロホル ム、ジクロロメタン、ジクロロエタン、トリクロロエチ レン等の脂肪族ハロゲン化炭化水素類、クロルベンゼ ン、ジクロルベンゼン等の芳香族ハロゲン化炭化水素 類、テトラヒドロフラン、ジオキサン等のエーテル類等 が用いられるがこれらに限られるものではない。

【0044】正孔輸送層は正孔輸送材料のみ、もしくは 正孔輸送材料を樹脂に溶解させた鍛液を輸布することに より形成される。本感光体に使用される正孔輸送材料 は、一般式[1]の化合物に加えて他の正孔輸送材料を 組み合わせて使用することもできる。一般式[1]の化 合物は、樹脂との相溶性が良く、結晶が折出しにくいの で、感度、耐久性の向上のために有利である。

【0045】電子写真特性、画像特性等の向上のために、必要があれば基板と有機層の間に下引き層を設けることができ、下引き層としてはポリアミド類、カゼイン、ポリビニルアルコール、ゼラチン、ポリビニルブチラール等の樹脂類、酸化アルミニウム等の金属酸化物などが用いられる。

【0046】本発明の材料は、有機EL素子もしくは電子写真感光体等の正孔輸送材料としのみでなく、光電変換素子、太陽電池、イメージセンサー等有機光導電材料のいずれの分野においても好適に使用できる。

[0047]

【実施例】以下、本発明を実施例に基づきさらに詳細に 説明する。

化合物(1)の合成方法

元素分析結果

C., H., N. ELT

計算値 (%) : C:89.83 H:6.22

N: 3. 95

実測値(%):C:89.52 H:6.47

N:4.01

この化合物の赤外吸収スペクトル(K B r 錠剤法)を図 6に示す。

【0048】 化合物 (2) の合成方法

フラスコ中に、9、9ーピス(4ーアミノフェニル)フルオレン34、8g、mーヨードトルエン81、3g、1、3ージメチルー2ーイミダブリジノン100g、前性カリ78、3gおよび塩化第一鯯0、1gを入れて、窒棄雰囲気下200℃で12時間反応させた。反応終了後、60℃まで冷却し、酢酸エチルで希釈してろ過した。ろ液を減圧下で濃縮して得た残渣を、トルエンから再結晶して48、5g待た。質量分析、赤外繰吸収スペクトル、NMRスペクトル分析の結果、化合物(2)であることがわかった。以下に生成物の元素分析結果を示す。

元素分析結果

Cir Hai No Elt

計算値 (%): C:89.83 H:6.22

N: 3. 95

実測値 (%):C:89.68 H:6.51

N: 3. 81

この化合物の赤外吸収スペクトル (KBr旋剤法) を図 7に示す。

【0049】実施例1

洗浄した I T O 電極付きガラス板上に、化合物 (1) の 発光層を、真空蒸着法により瞑厚 5 0 0 オングストロームで形成して、有機 E L 素子を作製した。発光層は 1 0 " T o r r の真空中で、基板湿度窒湿の条件下で蒸着した。その上に、蒸着法によりマグネシウムと銀を I 0: 1 で混合した合金で 1 5 0 0 オングストロームの映厚の 電極を形成して図 1 に示す有機 E L 素子を得た。この素子は、直流電圧 1 0 Vで 5 3 c d / m"の発光輝度と 1、8 m l / Wの発光効率を有していた。

【0050】実施例2

洗浄したITO電極付きガラス板上に、化合物(3)を
クロロフォルムに溶解分散させ、スピンコーティング法
により発光層を形成して、500オングストロームの膜
厚の発光層を得た。その上に、マグネシウムと銀を !
0:1で混合した合金で1500オングストロームの膜
厚の電極を形成して図1に示す構成の有機EL素子を得
た。この素子は、直流電圧10Vで42cd/m²の発
光輝度と1.2ml/Wの発光効率を有していた。
【0051】実施例3

洗浄した I T O 電極付きガラス板上に、化合物 (5)、N、N' ジフェニルーN、N'ー (3ーメチルフェニル) - 1、1'ーピフェニルー4、4'ージアミン、ポリーNーピニルカルバゾールを3:2:5の比率でクロロフォルムに溶解分散させ、スピンコーティング法により1000オングストロームの膜厚の発光層を得た。その上に、マグネシウムと銀を10:1で混合した合金で150500オングストロームの膜厚の電極を形成して図1に

(11)

特開平7-145372

示す有機EL素子を得た。この素子は、直流電圧10V で130cd/mⁱの発光輝度と2.0ml/Wの発光 効率を有していた。

19

【0052】実施例4

洗浄したITO電極付きガラス板上に、N,N'ージフ $x=\nu-N$, $N'-(3-y+\nu)=\nu-1$, 1'-ピフェニルー4, 4'ージアミンを真空蒸着して、30 0オングストロームの膜厚の正孔注入層を得た。次い で、真空蒸着法により化合物 (1) の膜厚500オング ストロームの発光層を作成し、その上に、マグネシウム 10 感光体を作製した。 と銀を10:1で准合した合金で1500オングストロ - ムの膜厚の電極を形成して図2に示す有機EL素子を 得た。正孔注入屬および発光層は10~4丁orrの真空 中で、基板温度室温の条件下で蒸着した。この素子は、 直流電圧10Vで約200cd/m゚の発光輝度と2. 7ml/Wの発光効率を有していた。この結果から、本 発明の化合物は電子輸送をする発光物質であることが解 る。

【0053】実施例5

洗浄したITO電極付きガラス板上に、化合物(1)を 20 真空蒸着して、300オングストロームの膜厚の正孔注 入屬を得た。次いで、トリス(8-ヒドロキシキノリ ン)アルミニウム錯体を真空蒸着して膜厚500オング ストロームの発光層を作成し、その上に、マグネシウム と銀を10:1で混合した合金で1500オングストロ 一ムの順厚の電極を形成して図2に示す有機EL素子を 得た。正孔注入層および発光層は10°Torrの真空 中で、基板温度室温の条件下で蒸着した。この素子は、 直流電圧10Vで約310cd/m の発光輝度と4. 6ml/Wの発光効率を有していた。

【DD54】実施例6

洗浄したITO電板付きガラス板上に、N, N'-ジフ ェニル-N, N'-(3-メチルフェニル) -1, 1'-ピフェニルー4、4'ージアミンを真空蒸着して、腰厚 300オングストロームの正孔注入層を得た。次いで、 真空蒸着法により化合物 (6) の膜厚200オングスト ロームの発光層を作成し、さらに真空蒸着法により[2] - (4 - tertーブチルフェニル) - 5 - (ピフェニ ル) -1, 3, 4-オキサジアゾール]の膜厚200オ ングストロームの電子注入層を得た。その上に、マグネ シウムと銀を10:1で混合した合金で膜厚1500オ ングストロームの電極を形成して図3に示す有機EL素 子を得た。この素子は、直流電圧10Vで約390cd /m^{*}の発光輝度と4.2ml/Wの発光効率を有して いた。

【0055】本実施例で示された全ての有機EL素子に ついて、1mA/cm²で連続発光させたところ、10 0 0 時間以上安定な発光を観測することができた。 太発 明の有機EL素子は発光効率、発光輝度の向上と長寿命 化を達成するものであり、併せて使用される発光物質、 発光補助材料、正孔輸送材料、電子輸送材料、增感剤、 樹脂、電極材料等および素子作製方法を限定するもので

20

【0056】実施例7

τ型鍋フタロシアニン4g、化合物(4)2g、ポリエ ステル樹脂 (バイロン200:東洋防 (株) 製) 14g をテトラヒドロフラン80gと共にボールミルで5時間 分散した。この分散液をアルミニウム基板上に竣工、乾 燥して、図4に示す饃厚20ミクロンの単層型電子写真

【0057】実施例8

ジプロモアントアントロン 6 g、化合物 (6) 2 g、ポ リエステル樹脂 (バイロン200:東洋防 (株) 製) 1 2gをテトラヒドロフラン80gと共にボールミルで5 時間分散した。この分散液をアルミニウム基板上に途 工、乾燥して、図4に示す膜厚20ミクロンの単層型電 子写真感光体を作製した。

【0058】実施例9

τ型無金属フタロシアニン2g、ポリピニルブチラール 樹脂 (BH-3:積水化学 (株) 製) 2gをテトラヒド ロフラン96gと共にボールミルで2時間分散した。こ の分散液をアルミニウム基板上に輸工、乾燥して、膜厚 0. 3ミクロンの電荷発生層を作製した。次に化合物 (2) 10g、ポリカーボネート樹脂 (L-1250; 帝人化成〈株)製)10gをジクロロメタン80gに溶 解した。この絵液を電荷発生層上に竣工、乾燥して、膜 厚20ミクロンの正孔輸送層を形成し、図5に示す積層 型電子写真感光体を作製した。

実施例10

30 N. N' -ビス (2, 6-ジクロロフェニル) -3, 4, 9, 10-ベリレンジカルボキシイミド2g、ポリ ビニルブチラール樹脂 (BH-3:積水化学(株)製) 2gをテトラヒドロフラン96gと共にボールミルで2 時間分散した。この分散液をアルミニウム基板上に塗 工、乾燥して、膜厚 0.3ミクロンの電荷発生層を作製 した。次に化合物(2)10g、ポリカーボネート樹脂 (L-1250: 帝人化成 (株) 製) 10gをジクロロ メタン80gに溶解した。この徹液を電荷発生層上に塗 工、乾燥して、腠厚20ミクロンの正孔輪送層を形成 し、図5に示す積層型電子写真感光体を作製した。 【0059】電子写真感光体の電子写真特性は以下の方 法で測定した。静電複写紙試験装置 (EPA-810 0;川口電機製作所(株)製)により、スタティックモ

ード2、コロナ帯電は-5.2 (kV) 、5 (lux) の白色光を照射して、初期表面電位(V。)、V。と2秒 間暗所に放置した時の表面電位 (V:) の比(暗藏袞 率:DDR2=V2/Vb)、光欝光後に帯電量が初期の 1/2まで減少する時間から半減露光量感度(E.:) および光欝光3秒後の表面電位(VR1)を調べた。実 50 施例 7~10の電子写真感光体の電子写真特性を表 2 に 【表2】

(12)

特開平7-145372

22

示す。 [0060]

東海 例	ν _α (-ν)	DDR.	B _{INE}	V R s (~ V)
7	530	8 2	a. 3	1 5
8	590	9.5	2. 9	1 2
9	710	9-6	0. 7	8
10	720	9 5	1, 9	5

【0061】1万回以上繰り返して電子写真特性を測定 したところ、本実施例で示された全ての電子写真感光体 について、安定な表面電位、感度を得ることができた。 【発明の効果】本発明により、優れた正孔輸送能力を有 する化合物を得ることができた。本発明が提供した化合 20 【図 6】化合物 1 の赤外吸収スペクトル 物は、従来に比べて高発光効率、高輝度であり、長寿命 の有機EL素子および感度、正孔輸送特性、初期表面電 位、暗滅衰率等の初期電子写真特性に優れ、繰り返し使 用に対する疲労も少ない電子写真感光体を得ることがで きた。

【図面の簡単な説明】

【図1】実施例で使用した有機EL素子の概略構造を表

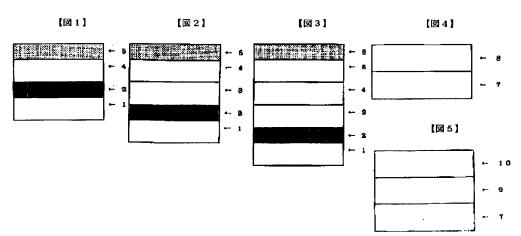
【図2】実施例で使用した有機EL素子の概略構造を表

【図3】実施例で使用した有機EL素子の概略構造を表 **す断面図**

【図4】実施例で使用した電子写真感光体の概略構造を 表す断面図

【図5】実施例で使用した電子写真感光体の概略構造を 表す断面図

- 【図7】化合物2の赤外吸収スペクトル 【符号の説明】
- 1. 基板
- 2. 電極A
- 3. 正孔注入層
- 4. 発光層
- 5. 電子注入層
- 6. 電板B
- 7. A1基板
- 30 8. 感光層
 - 9. 電荷発生層
 - 10. 正孔輸送層



21

(13)

特阱平7-145372

